

**Datenblatt** 

Klemmgehäuse 660nm Empfänger

## Photo-Empfänger 660nm, 5MBd

#### 1 Allgemeine Beschreibung

Das Bauelement ist speziell geeignet für Anwendungen mit Standard 1mm Kunststofflichtwellenleiter. Bestückt mit einer schnellen 660nm PIN-Diode mit TIA und Komparator für ein digitales Ausgangssignal, ist dieses Bauelement eine gute Alternative in Datenübertragungssystemen mit Kunststofflichtwellenleiter.

### 2 Anwendungen\_\_

Aufgrund der Datenübertragungsrate bis 5 MBd, den guten optischen Eigenschaften und der einfachen Anschlusstechnik des Lichtwellenleiters, findet das Bauelement eine Vielzahl von Anwendungsmöglichkeiten:

- · Optische Netzwerke
- Industrieelektronik
- Leistungselektronik
- Automotive
- Consumer Elektronik
- Lichtschranken



#### Ausführung

660 nm Empfänger (liegende Ausführung) 660 nm Empfänger (stehende Ausführung)

#### Bestellnummer

905EM660KM001 905EM660KM002





Bild 1 Bestückte Klemmgehäuse

#### 4 Eigenschaften\_

- 660nm Photo-Empfänger
- · open-collector Ausgang
- 5MBd
- steckerlose LWL-Konfektionierung
- geeignet für alle Kunststofflichtwellenleiter mit einem Außendurchmesser von 2.2mm und einem Faserdurchmesser von 1mm
- · Schnellverriegelung (Handbetätigung)
- Kunststoffgehäuse
- geeignet f
  ür automatische Best
  ückung
- wellenlötfähig

### 5 Maßzeichnungen \_\_\_\_\_

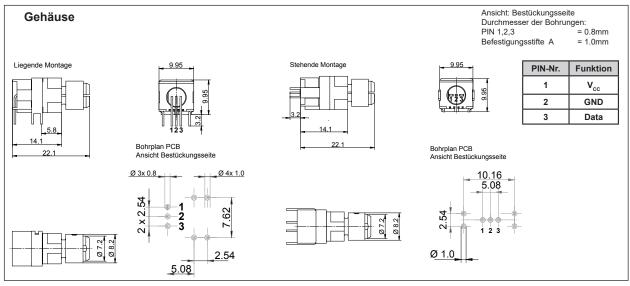


Bild 2



# Photo-Empfänger 660nm, 5MBd

5	Grenzwerte	

Belastungen die über die als `Grenzwerte` angegebenen hinausgehen können das Bauelement dauerhaft beschädigen. Die Grenzwerte stellen Belastungsgrenzen des Bauelementes dar. Der dauerhafte Betrieb mit diesen Werten wird nicht empfohlen, da die Zuverlässigkeit des Bauelementes darunter leiden kann.

Parameter	Wert	Einheit	
Betriebstemperatur	-40 +85	°C	
Lagertemperatur	-40 +100	C	
Löttemperatur 2mm vom Gehäuse, t ≤ 5s	260	°C	
Versorgungs-/Ausgangs- spannung	-0.5 bis 15	V	
Betriebsspannung für Funktion	≤ 4		
Pullup-Widerstand V <sub>cc</sub> =5V	330	Ω	
Ausgangsstrom	50	mA	
Verlustleistung	100	mW	

## 6 Technische Daten\_\_\_\_\_

Parameter	Symbol	Bedingung	Min	Тур	Max	Einheit
Wellenlängen- bereich	λ <sub>80%</sub>		600		780	nm
Schwerpunkt- wellenlänge	$\lambda_{Smax}$			700		nm
Übersteuerungs- grenze	P <sub>IN(max)</sub>	λ=650nm	252	1000		\^/
Max. Empfindlichkeit	$P_{IN(L)}$	POF, λ=650nm	20	6.3		łΨW
Laufzeit-	t <sub>PHL</sub>	Eingabemuster 1010, 5MBd			120	ns
verzögerung	t <sub>PLH</sub>				270	
Leerlaufspannung	V <sub>OH</sub>	R=330Ω	V <sub>cc</sub> -0.6	V <sub>cc</sub> -0.3		V
Leenauispannung	$V_{\scriptscriptstyle OL}$			0.2	0.6	
Schaltzeiten 10%-90%	t <sub>r</sub>	Eingabemuster 1010, 5MBd		14	30	- ns
90%-10%	t <sub>f</sub>			4	15	
	I <sub>cc</sub>	Eingabemuster 1010, 5MBd	8	14	20	
Stromverbrauch	I <sub>ccн</sub>	Logisch 1, Licht aus	1.5	3.5	6.5	mA
	I <sub>CCL</sub>	Logisch 0, Licht an	13	17.5	23	

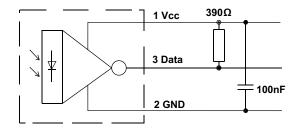


Rev. A03 T05EM660KM001



# Photo-Empfänger 660nm, 5MBd

#### 8 Schaltungsbeispiel\_\_\_



#### Hinweise:

- Vermeiden Sie Störsignale auf den Versorgungsleitungen.
- Platzieren Sie einen 100nF Entkoppelkondensator so nah wie möglich an den Empfänger.
- Halten Sie die Leiterbahnen für GND und Data so kurz wie möglich.
- Vermeiden Sie Fremdlichteinstreuung.
- Schützen Sie den Empfänger vor Verschmutzung.

Alle Informationen in den Datenblättern von Ratioplast-Optoelectronics GmbH wurden nach besten Wissen und Gewissen erstellt. Sie werden regelmäßig kontrolliert und aktualisiert. Für eventuell noch vorhandene Irrtümer oder Fehler wird keine Haftung übernommen. Änderungen vorbehalten.

USt.-ID-Nr.: DE 164 216 351 Amtsgericht Bad Oeynhausen HRB 2382